@ 日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60~195957

@Int_Cl_4

庁内整理番号 識別記号

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

母公開 昭和60年(1985)10月4日

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

の特 爾 昭59-50939

₩ 顧 昭59(1984)3月19日

切発 明 者

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

の出 麗 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の代 選 人 弁理士 高橋 明夫

外1名

発明の名称 リードフレーム

符許請求の範囲

1. 偏面に突出部を設けて成ることを特徴とする リードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラスチックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 配鉄のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、作に、モール ドレジンとの密着性を良くし、對止性のよい樹脂 対止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔 背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1日に 示すごときものが異知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。第1図に て、1は半導体チップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 . . .

体チップの内部配銀をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード何の電板及 * び半導体チップ舞の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的姿貌を行った後に、樹脂(レ **ジン)を周知のトランスファーモールド法などに** より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体設置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂封止歴半導体装置化あっ `ては、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、対止性(耐度性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その何面が フラットに構成されており、リードフレームとレ **ツンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上** という面で問題があることがわかった。

[発明の目的]

本発明はリードフレームとレジンとの簡悪(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの簡悪性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止選半導体製量を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および続付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本順において関示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 取付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面模増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの優気等の浸透性具物の侵入 の半導体チェブへの到達時間を長くして、剣止性 を向上させ、製品券命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

(実施例)

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの、要部針視回、 第3回は第2回I-I静脈面図を示す。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂割止型半導体接置の断面図を示し、第4回に て、9は半導体チェブ、10はコネクタワイヤ、 11は樹脂割止体、12はリードフレームで半導 体チェブ9を搭載しているタブ13、及び半導体 チェブ9の内部配銀をコネクタワイヤ10を用い て外部に引出するリード14にはそれぞれ央出部 15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えば シリコン単語品基板より成り、周知の技術によっ て、このチップ内には多数の間路素子が形成され、 1つの回路機能を与えている。個路業子は例えば 絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトラ ンジスタ)から成り、これらの回路業子によって、 例えば論理回路およびメモリの阻路像能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミ ニウム(A8)細細により構成される。

樹脂封止体)1は、例えばエボキン樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の ... 実施例を示し、第2 図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関係で横方向に 複数の線条の溝部16を設けて成る実施例を示す。 近時、第4 図に示すような樹脂封止型半導体装置 において、半導体チップ9 が大形化し、リード14 の樹脂封止体11 に埋込まれる長さが次第に短く なってきている。そうすると、リード14を折曲 げて第4 図に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが樹脂対止体外部によけいに 引っぱり出されることになる。かかる溝部16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密着性を向上し得る。

〔効 果〕

(1) リードフレームの切断面に段付けを行ない、 舞画に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密層面積が増大し、 リードフレームとレジンの密層性の向上が図られる。

(2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

特惠昭60-195957(3)

かつ、偶面がフラットである場合に比較して、収 が形成されているのでリータペスが長くなり、そ の結果外部からの半導体製置内部への浸透性異物 の侵入が遅くなり封止性(耐湿性)が向上する。 (3) リードフレームとレジンとの密着性。對止性 の向上により製品寿命を延命し、樹脂製止塩半導 体装置の信頼性を着しく向上することができる。 (4) 半導体チャブが大型化し、リードのモールド レジン中へ組め込まれている部分が増々似くなっ ている今日、リードフレームに設付けを行い、リ ードフレームとレジンとの密着性の食上の殴り、 対止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得 ることは工業上集めて有意義である。

(5) リードフレームの何難に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの告着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に誑し、リードがゆるん だり、樹脂封止体の外部に突出したりすることを 防止できる。

以上本張明者によってなされた発明を実施費に もとづき具体的に関切したが、本発明は上配実施 例に限定されるものではなく、その要旨は逸殿し ない鉱田で量々変更可能であることはいうまでも ない。

例上は、前記実施例では、リードフレーム側面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 福を設けても無支えない。又前記実施例では講部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに散けてもよい。

[利用分野]

本発明はデュアルインライン(DIL)メイブのペ ッケージの位、フラットペッタタイプのパッケージ たと他の機能対止理半導体装置にも適用すること ができ、樹脂封止型半導体装置全紋に適用できる。 又電子部品のペッケージ技能にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3例比第2图1-【被断面图、

第4回は本発明リードフレームを使用して成る 樹間対止型半導体装置の断面図、

第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレ

ームの平面図である。

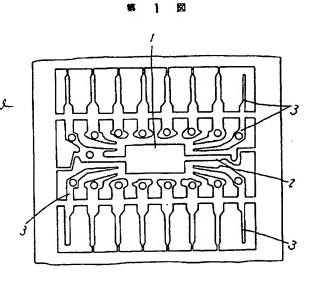
1…タブ、2…タブ吊りリード、3、…リード、 4…メブ、5…メブ品がリード、6…リード、7

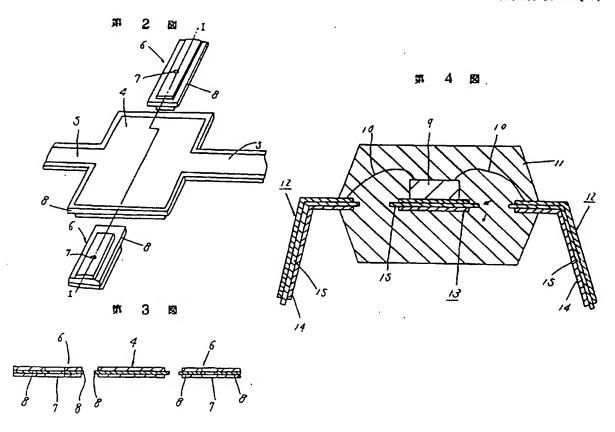
…樹脂穴、8 …突出部、9 …半導体デップ、10 …コネクタワイナ、11…樹田對止体、12… pleastfaml

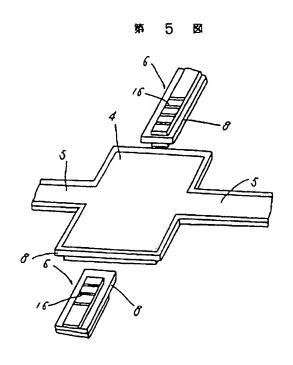
- F7V-4, 13 ··· \$7, 14 ··· 9 - F, 15

…突出部、16…壽部。

代理人 弁理士







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor:

Tsuji Masahiro

Applicant:

Rohm Co., Ltd.

Filed:

Oct. 23, 1992

Disclosed:

May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.